УДК 621.315.592.

ISSN1729-4428

Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк, В.І. Маковишин, Р.С. Яворський

Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів LAST Pb₁₈Ag_{2-x}Sb_xTe₂₀ на слюді

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна, E-mail: <u>fcss@pu.if.ua</u>

Досліджено термоелектричні властивості тонких плівок Pb₁₈Ag_{2-x}Sb_xTe₂₀, отриманих конденсацією пари у відкритому вакуумі на слюдяні підкладки. На основі двошарової моделі Петріца знайдено електричні параметри приповерхневих шарів. Показано, що конденсати товщиною d<1 мкм характеризуються покращеними термоелектричними властивостями.

Ключові слова: тонкі плівки, плюмбум телурид, питомий опір, рухливість.

Стаття поступила до редакції 11.12.2014; прийнята до друку 15.12.2014.

Вступ

Плюмбум телурид – ефективний термоелектричний матеріал для середньотемпературної області (500-750) К та джерел і сенсорів інфрачервоного випромінювання оптичного спектру. Значний інтерес до його дослідження, який не зменшується впродовж багатьох років, зумовлений як унікальністю фізико-хімічних властивостей, так і технологічністю отримання якісних кристалів і тонкоплівкових структур [1-3].

Сполуки LAST на основі PbTe ($Pb_mAg_{2-x}Sb_xTe_{m+2}$) в останній час також привертають увагу, завдяки значній чутливості їх властивостей до хімічного складу і можливості отримувати матеріал як n- так і p-типу [4]. Тонкоплівковий конденсат через вплив структури, поверхні, товщини на явища переносу розширює можливості використання сполук LAST.

У даній роботі досліджено закономірності зміни термоелектричних параметрів та особливості механізмів розсіювання носіїв струму у парофазних структурах Pb₁₈Ag_{2-x}Sb_xTe₂₀ на слюді від їх товщини.

I. Методика експерименту

Плівки для дослідження отримували осадженням пари наперед синтезованого матеріалу у вакуумі на свіжі сколи (0001) слюди-мусковіт. Температура випарника складала Тв=870 К, а температура підкладок Тп=470 К. Товщину плівок задавали часом осадження $\tau \approx (15-410)$ с в межах d=(180-6.7 103) нм. Синтез сполук для наважок складів Pb₁₈Ag_{0.5}Sb_{1.5}Te₂₀, Pb₁₈Ag_{1.5}Sb_{0.5}Te₂₀ проводили із чистих елементів у

вакуумованих до залишкового тиску 10⁻⁴ Па кварцових ампулах при температурі 1240 К на протязі 48 год.

Фазовий склад і структуру досліджуваних конденсатів визначали на автоматичному дифрактометрі STOE STADI Р (виробник фірма "STOE & Cie GmbH", лінійним позиційно-прецизійним Німеччина) 3 детектором PSD за схемою модифікованої геометрії Гіньє. Первинну обробку експериментальних дифракційних розрахунок масивів, теоретичних дифрактограм відомих сполук з метою ідентифікації фаз, уточнення параметрів елементарних комірок проводили за допомогою пакету програм STOE WinXPOW (версія 3.03) та PowderCell (версія 2.4).

Морфологію поверхонь отриманих конденсатів досліджували методами атомно-силової мікроскопії (ACM) Nanoscope 3a Dimention 3000 (Digital Instruments USA) у режимі періодичного контакту. Вимірювання проведені в центральній частині зразків з використанням серійних кремнієвих зондів NSG-11 із номінальним радіусом закруглення вістря до 10 нм (NTOMDT, Росія). За результатами ACM-досліджень у програмі WSxM 4.0 Develop 10.4 визначені розміри окремих нанокристалів.

Вимірювання термоелектричних параметрів конденсату проводили при кімнатних температурах у постійних магнітних і електричних полях на розробленій автоматизованій установці, яка забезпечує як процеси вимірювання електричних параметрів, так і реєстрацію і первинну обробку даних. Вимірюваний зразок мав чотири холлівські і два струмові контакти. В якості омічних контактів використовувалися плівки срібла. Струм через зразки складав ≈ 1 мА. Магнітне поле було напрямлене перпендикулярно до поверхні плівок при індукції 1,5 Тл.

II. Фазовий склад і структура

Приймаючи до уваги можливості Х-дифракційного фазового та структурного аналізів можна стверджувати, що досліджений конденсат виявився практично однофазним лише у випадку зразків чистого PbTe та сполуки LAST Pb₁₈Ag_{1,5}Sb_{0,5}Te₂₀.

Основною фазою в усіх зразках є PbTe структурного типу NaCl (просторова група Fm-3m). Додаткові фази у переважно слідових кількостях – Sb, Sb₂Te₃, Sb₈Te₃ виявились у сполук LAST інших досліджуваних складів.

На рис. 1 наведено АСМ-зображення поверхні наноструктур хімічних складів Pb₁₈Ag_{0.5}Sb_{1.5}Te₂₀ та Рb₁₈Ag_{1,5}Sb_{0,5}Te₂₀. Видно, що парофазний конденсат сформований i3 нанорозмірних кристалітів пірамідальної форми. Встановлено, що середні розміри нанокристалітів із товщиною конденсату збільшуються (рис. 1; 2). Зміна хімічного складу не значно впливає на форму та розміри нанокристалітів, але для структур на основі сполук Pb₁₈Ag_{0,5}Sb_{1,5}Te₂₀ їх розміри з ніж товщиною зростають значно швидше лля Рb₁₈Ag_{1,5}Sb_{0,5}Te₂₀ (рис. 2).



Рис. 1. 3D ACM зображення (а), профілограми (б), та гістограми розподілу висот (в) нанокристалітів: Pb₁₈Ag_{0,5}Sb_{1,5}Te₂₀ - I, II; Pb₁₈Ag_{1,5}Sb_{0,5}Te₂₀ - III, IV на поверхні конденсатів, осаджених на сколах(0001) слюдамусковіт товщоною d, нм: 270(I), 2430(II) 405(III), 1809 (IV).



0 500 1000 1500 2000 2500 d, нм Рис. 2. Залежність середніх розмірів нанокристалітів (D) від товщини (d) плівок: ■1 – Pb₁₈Ag_{0,5}Sb_{1,5}Te₂₀; •, 2 – Pb₁₈Ag₁-Sb₁Te₂₀; ▲, 3 – Pb₁₈Ag_{1,5}-Sb_{0,5}Te₂₀.

$$\sigma = \frac{\sigma_{s}d_{s} + \sigma_{b}d_{b}}{d}; \qquad (1)$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{R}_{s}\sigma_{s}^{2}\mathbf{d}_{s} + \mathbf{R}_{b}\sigma_{b}^{2}\mathbf{d}_{b}}{\left(\sigma_{s}\mathbf{d}_{s} + \sigma_{b}\mathbf{d}_{b}\right)^{2}}\mathbf{d}; \qquad (2)$$

$$S = \frac{\sigma_s d_s S_s + \sigma_b d_b S_b}{\sigma_s d_s + \sigma_b d_b}.$$
 (3)

За умови відомих експериментальних значень σ , R, μ та об'ємних σ_b , R_b, μ_b і d, із даних співвідношень можна наближено визначити параметри приповерхневих шарів σ_s , R_s, μ_s відповідно, значення яких наведені в таблиці. Видно (рис. 3 – суцільні лінії), що розраховані криві задовільно описують експериментально отримані результати за визначених значень приповерхневих електричних параметрів d_s, σ_s , R_s, n_s, μ_s (табл. 1).



Рис. 3. Залежності питомої провідності (σ), холлівської концентрації (n) та термоелектричної потужності (S²σ) від товщини плівок: Pb₁₈Ag_{0.5}Sb_{1.5}Te₂₀(●, 1); Pb₁₈Ag₁-Sb₁Te₂₀ (▲, 2); Pb₁₈Ag_{1.5}-Sb_{0.5}Te₂₀(■, 3) на свіжих сколах (1000) слюда-мусковіт. Точки – експеримент, суцільні лінії – розрахунок згідно моделі Петріца.

Ш. Вплив товщини на термоелектричні параметри

Із рис. 3, а видно, що зі зменшенням товщини d провідність плівок, незалежно від складу, суттєво зростає з виходом на насичення при d \approx 1 мкм. У даному випадку мають вплив поверхневі ефекти, які зі зростанням товщини стають незначними.

Схожу поведінку має холлівська концентрація носіїв струму (рис. 3, б): зі зростанням товщини плівок концентрація спадає у декілька разів.

Термоелектрична потужність $S^2 \sigma$ зростає зі зменшенням товщини (рис.3, в). Причому вона є найбільшою для плівок складу $Pb_{18}Ag_{1,5}Sb_{0,5}Te_{20}$ за рахунок значної провідності.

Отримані експериментальні результати (рис. 3) пояснено у рамках двошарової моделі Петріца [5]. Тонку плівку у цій моделі представляють складеною з двох шарів: приповерхневого (I) (область поверхневого заряду) завтовшки d_s , концентрація носіїв струму в якому n_s , а їх рухливість μ_s , і об'ємного (II), що характеризується аналогічними величинами: d_b , n_b , μ_b які з'єднані паралельно. Товщина плівки $d = d_s + d_b$.

У цьому випадку згідно [5]:

Значення параметрів приповерхневого шару (s) і об'єму (b) для плівок LAST на слюді, розраховані згідно двошарової моделі Петріца.

Таблиця

Параметри	$Pb_{18}Ag_{0,5}$ - Sb _{1.5} Te ₂₀	$Pb_{18}Ag_{1}$ - Sb ₁ Te ₂₀	$Pb_{18}Ag_{1,5}$ - Sb _{0.5} Te ₂₀
d _s , мкм	0,254	0,25	0,38
σ_s , $Om^{-1}cm^{-1}$	240	530	1000
σ_b , $Om^{-1}cm^{-1}$	1	0,7	5
R _s , см ³ Кл ⁻¹	-0,165	-0,1	-0,06
R _b , см ³ Кл ⁻¹	-420	-84	-9,3
n_s, cm^{-3}	$3,78 \cdot 10^{19}$	$6,25 \cdot 10^{19}$	$1,04 \cdot 10^{20}$
n_b, cm^{-3}	$1,48 \cdot 10^{16}$	$7,4 \cdot 10^{16}$	$6,7 \cdot 10^{17}$
$\mu_{\rm s}, {\rm cm}^2 {\rm B}^{-1} {\rm c}^{-1}$	39,6	53	60
μ_b , $c M^2 B^{-1} c^{-1}$	420	58,8	46,5
S _s , мкВ/К	-220	-190	-200
S _b , мкВ/К	-100	-50	-105
$S_s^2 \sigma_s$, мкВт/К ² см	11	19	40
$S_b^2 \sigma_b$, мкВт/К ² см	0,01	0,002	0,055

Важливо відзначити, що концентрація електронів приповерхневого шару n_s значно більша за об'ємну. Це пов'язано з особливостями взаємодії срібла із атмосферним киснем. Поверхневі значення питомої

електропровідності та коефіцієнта Зеєбека є зачно більшими ніж аналогічні параметри для об'ємного шару. За рахунок цього спостерігаються високі значення питомої термоелектричної потужності, які на декілька порядків перевищують об'ємні ($S_s^2 \sigma_s \approx 11-40 \text{ мкВт/K}^2 \text{см}$).(табл.)

IV. Механізми розсіювання носіїв струму

Експериментально отримані товщинні dзалежності рухливості (μ) (рис 4) можна пояснити механізмами розсіювання носіїв струму на міжзеренних межах (μ_3) та поверхні (μ_{π}) конденсатів [6]. Так, зокрема, рухливість (μ) носіїв заряду у плівках якщо їх концентрація і ефективна маса є сталими визначається правилом Маттісена [6]:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{\rm m}} + \frac{1}{\mu_{\rm s}},\tag{4}$$

де µ – експериментально визначена рухливість.

Час між двома актами розсіювання на межах кристалітів τ_3 визначається як

$$\tau_{3} = D\upsilon^{-1}, \qquad (5)$$

де v – теплова швидкість носіїв. При цьому згідно [7]:

$$\mu_3 = \frac{2q}{h} D\left(\frac{3n}{\pi}\right)^{-1/3},\tag{6}$$

де D – середній розмір зерна, q – заряд носіїв, n – концентрація носіїв, h – стала Планка.

Рухливість носіїв струму у випадку дифузного розсіювання на поверхні визначається як [8]:

$$\mu_{\rm m} = \mu_{\rm v} (1 + \lambda / d)^{-1} \,. \tag{7}$$

Тут λ – середня довжина вільного пробігу носіїв, μ_{v} – рухливість об'ємного матеріалу.

Згідно моделі Тейлєра [9] розсіювання носіїв заряду на межах зерен описується часом релаксації τ_0 таким чином, що $\lambda = \tau_0 \upsilon$, де λ – ефективний середній вільний пробіг носіїв заряду у нескінченно товстій плівці. Тоді

$$s = s_0 \left[1 - \frac{3}{8} I \frac{(1-P)}{d} \right].$$
 (8)

Тут σ_0 – питома електропровідність у нескінчено товстій плівці. Рівняння (8) виражає пряму лінію у = A ± Bx у координатах $\sigma \sim d^{-1}$, де A = σ_0 ; B = $-\frac{3}{8}s_0I(1-P)$.

Із рівняння (8) випливає, що пряма лінія пересікає вісь ординат при d⁻¹ \rightarrow 0 у точці, що визначає σ_0 . Тангенс кута нахилу прямої визначає величину в яку входить λ . Якщо розглядати дифузне розсіювання (тобто P=0), то можна визначити λ і σ_0 . Знаючи довжину вільного пробігу (λ), та використавши формулу (7) маємо залежність поверхневої рухливості μ_{Π} від товщини. Аналогічно за середніми розмірами кристалітів (D) та експериментальне значення концентрації (n_H) із виразу (6) отримаємо величину рухливості яка враховує вплив розсіювання носіїв на міжзеренних межах (μ_3).



Рис. 4. Залежність питомої провідності (σ) від оберненої товщини (1/d) для плівок: 1,• – Pb₁₈Ag_{0.5}Sb_{1.5}Te₂₀, 2,■ – Pb₁₈Ag_{1.5}Sb_{0.5}Te₂₀.



Рис. 5. Залежність сумарної рухливості носіїв струму (μ) – 3 та рухливості носіїв струму при врахуванні розсіювання на поверхні (μ п) – 1 і розсіювання на межах зерен (μ з) – 2 від товщини (d) для свіжовирощених плівок (Pb₁₈Ag_{0.5}Sb_{1.5}Te₂₀ (a); Pb₁₈Ag₁Sb₁Te₂₀ (б). Суцільні лінії – розрухунок згідно (4), (6), (7); точки – експеримент.

Рухливість носіїв струму (μ) дещо зростає із збільшенням d (рис. 5). Останне добре корелює також із характером зміни розмірів нанокристалітів (рис. 2).

Для кімнатних температур згідно експериментальних залежностей питомої електропровідності (σ) від оберненої товщини (1/d) конденсатів (рис. 4) середня довжина вільного пробігу λ носіїв струму розрахована згідно моделі Тейлора, для тонких плівок на основі Pb₁₈Ag_{0.5}Sb_{1.5}Te₂₀ складає ~ 70 нм, а для Pb₁₈Ag₁Sb₁Te₂₀ ~ 68 нм, що пов'язано з різною структурною досконалістю конденсатів (рис. 2).

На основі аналізу результатів досліджень (рис. 5) можна стверджувати, що основний внесок у рухливість носіїв заряду дає дифузне розсіювання на поверхні (µ_n)

(рис. 5, – крива 1), вплив міжзеренних меж (µ₃) значно менший завдяки зростанню розмірів зерен.



Рис. 6. Залежність сумарної рухливості носіїв струму (μ) від товщини (d) для свіжовирощених плівок (Pb₁₈Ag_{0.5}Sb_{1.5}Te₂₀ (1, **•**); Pb₁₈Ag_{1.5}Sb_{0.5}Te₂₀ (**1**, **•**); Pb₁₈Ag_{1.5}Sb_{0.5}Te₂₀ (**1**, **•**)). Суцільні лінії – розрухунок згідно (4); точки – експеримент.

На рисунку 6 зображені сумарні рухливості носіїв заряду для всіх складів LAST Pb_mAg_{2-x}Sb_xTe_{m+2} (x=0,5; 1; 1,5). Відмінна зміна рухливості носіїв μ від товщини d для конденсатів Pb₁₈Ag_{1,5}Sb_{0,5}Te₂₀ (рис 6 – крива 3) (зростання μ зі зменшенням товщини) може бути пов'язана з домінуванням дзеркального розсіювання над дифузним. Останнє зумовлено тим, що цей конденсат є фазово однорідний, а його поверхня при малих товщинах характеризується незначною шорсткістю, яка складає ~ 0,1 нм, що є значно менше за довжину вільного пробігу носіїв.

Висновки

1. Досліджено термоелектричні властивості тонких плівок Pb₁₈Ag_{2-x}Sb_xTe₂₀, складу x=0,5; 1; 1,5 отриманих на слюдяних підкладках.

2. З використанням моделі Петріца визначено термоелектричні параметри приповерхневого шару, які відрізняються більшим значенням від об'ємних величиною концентрації носіїв, питомою електропровідністю, коефіцієнтом Зеєбека.

3. Показано, що конденсати товщиною d < 1 мкм характеризуються покращеними термоелектричними властивостями.

Робота виконана згідно комплексного наукового проекту МОН України (державний реєстраційний номер 0115U002303).

This research is sponsored by NATO's Public Diplomacy Division in the framework of "Science for Peace" (NATO SPS 984536)).

Фреїк Д.М. – заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор, директор Фізикохімічного інституту, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла; **Дзундза Б.С.** – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; **Костюк О.Б.** – аспірант; **Маковишин В.І.** – аспірант; **Яворський Р.С.** – аспірант.

- [1] V.M. Shperun, D.M. Freik, R.I. Zapuhljak. Termoelektrika teluridu svincju ta jogo analogiv, 250 (Ivano-Frankivs'k: Plaj: 2000).
- [2] M.S. Dresselhaus, G. Chen, M.I. Tang, R. Yang, H. Lee, D. Wang, Z. Ren, J-P. Fleurial, P. Gagna. Adv. Mater. 19, 1043 (2007).
- [3] A.N. Kovalev, V.V. Ostroborodova, V.I. Paramonov, P.I. Folomin. Fizika i tehnika poluprovodnikov 11, 2039, (1989).
- [4] H. Wang et al., Appl. Phys. Lett. 88, 092104 (2006).
- [5] R.L. Petritz. Phis. Rev. (110), 1254 (1958)..
- [6] P.R. Vaya, J. Majht, B.S.V. Gopalam, C. Dattatrepan, Phys. Stat. Sol. (a), 87(341), 341 (1985).
- [7] Poverhnostnye svojstva tverdyh tel. Pod. red. M. Grina. (Mir, M. 1972).
- [8] D.M. Freïk, I.I. Chav'jak, B.S. Dzundza, O.B. Kostjuk. Fizika i himija tverdogo tila. 13(1), 73 (2012).
- [9] C.R. Tellier, A.J. Tosser, C. Boutrit. Thin Solid Films, 44, 201 (1977).
- ^[10] D.M. Freik, B.S. Dzundza, O.B. Kostyuk, V.I. Makovyshyn, R.S. Yavorskiy

Surface Layers and Thermoelectric Properties of Vapor-Phase Condensation LAST Pb₁₈Ag₂-_xSb_xTe₂₀ on Mica

¹Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University 57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine, E-mail: <u>fcss@pu.if.ua</u>

The thermoelectric properties of thin films $Pb_{18}Ag_{2,x}SbxTe_{20}$, obtained by condensation of vapor on the high vacuum on mica substrate are researched. Based on a two-layer model Petrits are founded electrical parameters of surface layers. It is shown that condensates thickness d <1 micron are characterized by improved thermoelectric properties.

Keywords: thin films, lead telluride, resistivity, mobility.